



発送番号: 456166 発送日: 平成21年 7月10日

拒絶査定

due date
10/10(z) → 10/13(K)

特許出願の番号	特願 2004-530559
起案日	平成21年 7月 3日
特許庁審査官	酒井 英夫 9631 4R00
発明の名称	半導体層構造のMBE成長
特許出願人	シャープ株式会社
代理人	山本 秀策 (外 2名)

この出願については、平成21年 4月 9日付け拒絶理由通知書に記載した理由1によって、拒絶をすべきものです。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。

備考

・請求項1-7に係る発明に対して

出願人は意見書において、InGaN層を成長させる場合の基板温度を、AlGaIn層を成長させる場合の基板温度よりも低くし、成長させるInGaIn層のInの含有量に応じて基板温度を変化させている点については、引用文献2には何ら開示されていない旨主張している。

しかし、アンモニアを窒素源としたMBE法によるIII族窒化物半導体の成長にあつて、III族元素としてInを含む場合にはその基板温度を低く設定すべきであることは、本願の優先日時の技術常識である（必要ならば、Journal of Applied Physics, Vol. 81, No. 12, p. 7966-7969、及び、APPLIED PHYSICS LETTERS, Vol. 72, No. 9, p. 1078-1080等を参照）ことから、引用文献2に記載の技術を、引用文献1に記載の構造の素子の製造に用いるに際して、InGaIn層の成長時の基板温度を、Inを含まない層を成長する際の基板温度よりも低くすることは、当然になされるべき事項である。

よって、平成21年4月9日付け拒絶理由通知書に記載した理由1は撤回しない。

(注) 法律又は契約等の制限により、提示した非特許文献の一部又は全てが送付されない場合があります。)

この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があつた日から3月以内（在外者にあつては、4月以内）に、特許庁長官に対して、審判を請求すること

整理番号: 発送番号: 456166 発送日: 平成21年 7月10日 2/E

ができます(特許法第121条第1項)。

(行政事件訴訟法第46条第2項に基づく教示)

この査定に対しては、この査定についての審判請求に対する審決に対してのみ
取消訴訟を提起することができます(特許法第178条第6項)。

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成21年 7月 9日 経済産業事務官 吉越 誠